

次世代半導体戦略を支える界面ナノ電子化学 ～国際情勢から最新ウェットプロセスまで～

趣旨 次世代半導体製造では、ウェットプロセスにおける気・液・固相界面の理解がますます重要となっている。本シンポジウムでは、国際情勢から物理洗浄、分子シミュレーション、帯電現象までを俯瞰し、次世代プロセス技術の課題と展望を議論する。

日時: 2026年9月10日(水)13:30 –17:00

場所: 北海道大学札幌キャンパス

F211 (フロンティア応用科学研究棟)

招待講演

- ◆ 半導体で国際情勢を読む
太田 泰彦 (北海道大学)
- ◆ 半導体洗浄における物理洗浄技術
南 輝臣 (東京エレクトロン九州)
- ◆ 三次元フラッシュメモリ開発におけるウェットプロセスへの分子シミュレーション活用
宮田 正靖 (キオクシア株式会社)
- ◆ H₂プラズマを用いたITO高温加工プロセスの表面反応メカニズム考察
(INE第9回ポスター発表展 優秀講演賞記念講演)
鈴木 涼平 (ソニーセミコンダクタソリューションズ)
- ◆ 枚葉半導体ウェットプロセスでの帯電現象
佐藤 雅伸 (SCREENセミコンダクターソリューションズ)
- ◆ インクジェット方式の半導体ウェット洗浄におけるシリコンウェハ帯電メカニズムの解明
土屋 雄貴 (リコー)

一般講演

- ◆ 衝突液体噴流を用いた枚葉式ウェハ洗浄における液体置換過程の数値解析
美和 誠人 (静岡大学)
- ◆ 二流体スプレー時のSiO₂ウェハの表面状態と表面帯電の関係性
佐藤 純大 (愛知工業大学)

界面ナノ電子化学研究会

シンポジウム世話人: 清家善之 (愛知工大) 真田 俊之 (静岡大)、新井豊子 (金沢大)、小川義宏 (キオクシア)、
吉田 勇喜 (関東化学)、大南 樹生 (関東化学) 連絡先: y_seike@aitech.ac.jp